

A22 信息披露 Disclosure

(上接 A21 版)

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红无需审计）。

3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（公司首次公开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司当年实现的母公司可供分配利润的 50%且超过 5000 万元人民币。

（四）现金分红的比例和间隔：

公司原则上每年进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议进行中期现金分红。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

在公司发展阶段的易区区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司当年实现的母公司可供分配利润的 50%且超过 5000 万元人民币。

（五）发放股票股利的前提

在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

（六）利润分配的决策机制和程序

1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预定分配方案，并经独立董事认可后方可提交董事会审议；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。

2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（七）利润分配政策调整决策机制与程序

1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化、确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并分别经监事会和二分之一以上独立董事认可后方可提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准，公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体董事的二分之一以上同意。”

（六）公司控股子公司、参股子公司基本情况

截至本招股书签署日，公司拥有新洁能香港、电基集成 2 家全资子公司以及新洁能深圳分公司、新洁能宁波分公司 2 家分公司，无参股子公司。具体情况如下：

1、新洁能香港

公司名称	新洁能功率半导体（香港）有限公司	成立时间	2010年 7 月 6 日
注册资本	51.00 万美元	实收资本	6.10 万美元
注册地址	香港皇后大道中 181 号新纪元广场（低座）1501 室		
经营范围	电力电子元器件的研发、生产、销售；集成电路的研发、销售和贸易		
股东名称	新洁能	股权比例	
		100.00%	
合计		100.00%	
2019年 12 月 31 日	2019年 12 月 31 日		
总资产	61.97	总资产	62.27
净资产	61.97	净资产	62.27
2019年度	2019年度		
净利润	-0.30	净利润	5.52

2、电基集成

公司名称	无锡电基集成科技有限公司	成立时间	2017年 3 月 21 日
注册资本	12,000.00 万元	实收资本	12,000.00 万元
注册地址	无锡市新吴区研发二路以南、研发一路以东		
经营范围	电子元器件、电力电子元器件及半导体模块产品及其它电子产品的设计、制造、销售；集成电路及其它电子产品的研发、设计、技术转让、技术服务、销售；计算机软件的研发、技术转让；环境保护专用设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股东名称	新洁能	股权比例	
		100.00%	
合计		100.00%	
2019年 12 月 31 日	2019年 12 月 31 日		
总资产	13,157.51	总资产	13,368.84
净资产	11,762.76	净资产	11,946.87
2019年度	2019年度		
净利润	-184.11	净利润	-44.70

3、新洁能深圳分公司

公司名称	无锡新洁能股份有限公司深圳分公司	成立时间	2013年 12 月 4 日
统一社会信用代码	914403000946106229		
经营场所	深圳市宝安区西乡街道西乡大道与前进二路交汇处美兰商务中心 802		
经营范围	电力电子元器件、集成电路、电子产品的设计、设计、技术转让、技术服务、销售；计算机软件的研发、技术转让；环境保护专用设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。环境保护专用设备的制造、销售。		

4、新洁能宁波分公司

公司名称	无锡新洁能股份有限公司宁波分公司	成立时间	2019年 10 月 10 日
统一社会信用代码	91330212MA2GU7ACX6		
经营场所	浙江省宁波市鄞州区实创中心 8 幢 26 号 10-6		
经营范围	电力电子元器件、集成电路、电子产品的设计、设计、技术转让、技术服务、销售；计算机软件的研发、技术转让；环境保护专用设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。		

第四节 募集资金运用

根据 2018 年 11 月 19 日通过的 2018 年第三次临时股东大会决议，公司拟申请向社会公开发行人民币普通股 A 股，发行数量为不超过 2,530.00 万股。募集资金总额将根据市场情况和向询价对象的询价情况确定。根据股东大会的授权，2020 年 6 月 2 日经公司第二届董事会第八次会议及 2020 年 7 月 31 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，对本次投资项目的募集资金使用金额进行调整。

本次发行 A 股募集资金计划全部用于以下与主营业务相关的项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	超低能耗高可靠性功率器件研发升级及产业化	48,118.04	20,000.00
2	半导体功率器件封装测试生产线建设	32,014.90	20,000.00
3	碳化硅宽禁带功率器件研发及产业化	11,419.27	-
4	研发中心建设	5,501.86	4,898.80
5	补充流动资金	5,000.00	-
合 计		102,064.07	44,898.80

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或债务方式筹集资金，先行投入。本次发行股票募集资金到位后，再予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于投资项目资金需求量，公司将通过银行贷款和其他自筹资金解决。

一、超低能耗高可靠性功率器件研发升级及产业化项目

本项目位于无锡新吴区，研发一路以东，研发二路以南地块。项目旨在对公司现有产品升级换代，开发新一代超低能耗高可靠性功率器件产品，突破超低能耗功率器件设计技术门槛，打破国外产品在高端应用领域的垄断地位。

本项目总投资额为 48,118.04 万元，具体投资构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资额	占比	第一年	第二年	第三年
1	固定资产投资	6,094.60	12.67%	3,689.40	2,405.20	-
1.1	设备投资	5,764.60	11.98%	3,369.40	2,405.20	-
1.2	土建投资	330.00	0.69%	330.00	-	-
2	研发费用	33,782.29	70.21%	7,067.47	11,353.53	15,361.29
2.1	开发费用	1,182.00	2.46%	198.00	442.00	542.00
2.2	试制费用	25,496.30	52.97%	5,394.91	8,548.49	11,542.90
2.3	封装测试费用	6,763.99	14.06%	1,424.56	2,263.03	3,076.39
3	软件投入	350.00	0.73%	50.00	100.00	200.00
3	折旧	1,120.00	2.33%	1,120.00	-	-
4	铺底流动资金	7,121.15	14.80%	2,373.72	2,373.72	2,373.72
合 计		48,118.04	100.00%	14,260.59	16,132.44	17,735.01

项目建设期为 36 个月，运营期为 T+1 期至 T+10 期。根据规划，项目建成后，运营期 T+1 期部分开发产品陆续正式投产，T+1 期达到设计产能的 40%，T+2 期产能达到 80%，T+3 期完全达产。根据可行性研究报告，在各项经济因素与可行性研究报告预期相符的前提下，本项目的经济效益评价指标

测算结果如下：

指标名称	指标值	
年平均销售收入（万元）	83,144.45	
年平均利润总额（万元）	7,491.05	
年平均上缴所得税（万元）	1,123.66	
年平均税后利润（万元）	6,367.39	
年总投资收益率	15.57%	
	所得税前	所得税后
内部收益率	24.15%	21.19%
财务净现值（ic=10%）（万元）	24,729.48	18,920.37
投资回收期（含建设期）	5.74	6.15

二、半导体功率器件封装测试生产线建设项目

本项目位于无锡新吴区，研发一路以东，研发二路以南地块。主要建设内容包括：针对公司现有的封装形式（DPAK/SOT/TO）进行产业链延伸；TO—247/TO—3P IGBT 及大功率 MOSFET 芯片封装；低热阻 SOP—8 封装的产业化；基于 Cu—Clip 工艺技术，实现高功率密度低功耗器件封装；芯片封装集成器件及大功率模块的研发和封装产业化。

本项目总投资额为 32,014.90 万元，具体投资构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资额	占比	第一年	第二年
1	固定资产投资	29,319.40	91.58%	20,671.40	8,648.00
1.1	设备投资	25,482.00	79.59%	16,834.00	8,648.00
1.2	土建投资	3,837.40	11.99%	3,837.40	-
2	软件投资	255.00	0.80%	-	255.00
3	铺底流动资金	2,440.50	7.62%	1,220.25	1,220.25
合 计		32,014.90	100.00%	21,891.65	10,123.25

项目建设期为 18 个月，运营期为 T+1 期至 T+10 期。运营期 T+1 期公司开始正式投产，产能利用率为 40%，T+2 期为 80%，T+3 到 T+10 期 100%完全达产。根据可行性研究报告，在各项经济因素与可行性研究报告预期相符的前提下，本项目的经济效益评价指标测算结果如下：

指标名称	指标值	
年平均销售收入（万元）	28,494.62	
年平均利润总额（万元）	5,107.24	
年平均上缴所得税（万元）	1,276.81	
年平均税后利润（万元）	3,830.42	
年总投资收益率	15.95%	
	所得税前	所得税后
内部收益率	16.52%	12.45%
财务净现值（ic=10%）（万元）	10,670.81	3,893.75
投资回收期（含建设期）	6.61	7.61

三、碳化硅宽禁带功率器件研发及产业化项目

本项目位于无锡新吴区，研发一路以东，研发一路以南地块。本项目是基于宽禁带半导体碳化硅材料的功率器件研发及产业化，包括 SiC SBD（肖特基二极管）及 SiC MOSFET 两类产品。本项目的实施旨在突破高压 SiC 功率器件关键技术，重点针对碳化硅二极管浪涌电流能力提升技术、碳化硅二极管雪崩耐量提升技术、沟槽底部氧化层峰値电势抑制技术、器件终端边缘电场疏导技术进行研发。开发碳化硅功率器件，打破国外产品在碳化硅宽禁带功率功率器件技术垄断，实现我国碳化硅功率器件的国产化。

本项目总投资额为 11,419.27 万元，具体投资构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资额	占比	第一年	第二年	第三年
1	固定资产投资	767.75	6.72%	426.65	341.10	-
1.1	设备投资	497.75	4.36%	156.65	341.10	-
1.2	土建投资	270.00	2.36%	270.00	-	-
2	研发费用	9,561.85	83.73%	1,667.62	2,850.19	5,044.04
2.1	开发费用	848.00	7.43%	224.00	312.00	312.00
2.2	试制费用	8,158.19	71.44%	1,345.55	2,374.71	4,437.93
2.3	封装测试费用	356.67	3.11%	59.07	103.48	194.11
2.4	IP core	300.00	1.75%	40.00	60.00	100.00
3	软件投资	280.00	2.45%	280.00	-	-
4	铺底流动资金	809.67	7.09%	269.89	269.89	269.89
合计		11,419.27	100.00%	2,644.16	3,461.18	5,313.93

项目建设期为 36 个月，即为 T+1 期至 T+3 期。根据规划，项目建设期公司将完成 SiC SBD 及 SiC MOSFET 系列产品的研发。同时，T+1 期部分开发产品陆续正式投产，T+1 期达到设计产能的 40%，T+2 期产能达到 80%，T+3 期完全达产。根据可行性研究报告，在各项经济因素与可行性研究报告预期相符的前提下，本项目的经济效益评价指标测算结果如下：

指标名称	指标值	
年平均销售收入（万元）	9,541.13	
年平均利润总额（万元）	855.04	
年平均上缴所得税（万元）	128.26	
年平均税后利润（万元）	726.78	
年总投资收益率	7.49%	
	所得税前	所得税后
内部收益率	16.64%	14.74%
财务净现值（ic=10%）（万元）	1,901.29	1,304.56
投资回收期（含建设期）	7.06	7.36

四、研发中心建设项目

本项目位于无锡新吴区，研发一路以东，研发二路以南地块。项目旨在完善和加强公司在功率功率器件领域的综合技术研发能力与项目开发产业化能力，依托公司研发中心，充分调动产业链核心技术资源，创新开发功率器件领域的新技术、新产品，打破国际大厂在高端功率器件上的长期垄断地位。研发中心计划开展的主要研发项目有：高性能高可靠性电机驱动系统中功率器件的研发与产业化、低能耗大功率 MOSFET 模块的研发及功率器件综合实验室的升级。

项目总投资为 5,501.86 万元，具体投资构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资额	占比	第一年
1	固定资产投资	5,335.86	96.98%	5,335.86
1.1	设备投资	4,870.86	88.53%	4,870.86
1.2	土建投资	460.00	8.45%	465.00
2	软件投资	166.00	3.02%	166.00
合 计		5,501.86	100.00%	5,501.86

本项目实施后，虽不产生直接的经济效益，但研发中心的建设将提升公司整体研发实力、提高核心竞争力、研发实力的提升可增强客户对公司的信任度，进一步强化公司的品牌优势，扩大市场份额，实现公司长远的战略目标。

五、补充流动资金项目

报告期内，公司发展迅速，经营规模呈现快速增长趋势。2016 年至 2018 年，公司分别实现营业收入 42,211.51 万元、50,375.98 万元和 71,579.03 万元，年复合增长率达到 30.22%。在国家半导体产业政策大力支持以及下游市场需求持续增长的背景下，预计未来公司经营规模仍将保持快速增长的趋势。公司资产主要以流动资产为主，公司日常经营较多涉及现款支付，折旧、摊销类的非现金支出相对较少。因此，公司需要保持较高水平的流动资金用于新产品技术研发、人才引进、原材料采购、市场营销等环节，以保持公司的竞争优势和行业领先地位，推动公司业务可持续发展。

通过补充流动资金，公司可进一步优化财务结构，防范经营风险，保证公司业务顺利开展，有利于公司扩大业务规模，提高公司的综合竞争力，为公司未来可持续发展创造宽松的资金环境和良好的融资条件。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

（一）市场风险

1、市场波动风险

半导体分立器件作为基础性电子元器件，为国民经济的多个领域所必不可少，因此半导体分立器件行业的下游分布极为广泛。广泛的下游应用领域提升了公司应对单一市场波动风险的能力，但半导体分立器件行业与宏观经济的整体发展的景气程度密切相关，国内经济整体增速放缓及中美贸易摩擦等因素通过对下游行业的生产经营产生不利影响进而传导至半导体分立器件行业。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，半导体分立器件行业的市场需求也将随之受到影响；下游行业的波动和低迷会导致对半导体分立器件的需求下降，价格敏感性提高。虽然近几年全球半导体分立器件市场保持稳步增长，且亚洲地区特别是中国市场规模增幅巨大，但是如果由于中美贸易摩擦等因导致下游市场整体持续波动、全球经济或国内经济发生重大不利变化，将对半导体分立器件行业及公司等行业内企业的经营业绩造成不利影响。

2、行业竞争风险

近年来随着我国消费电子、汽车电子、工业电子等多个行业的蓬勃发展以及新能源汽车/充电桩、智能装备制造、物联网、光伏新能源等新兴领域崛起，国内对半导体分立器件的需求迅速扩大，直接拉动了行业的快速发展，也吸引了国内外企业进入到行业内，市场竞争日趋激烈。一方面，国内半导体分立器件企业不断增加，且部分企业不断通过技术升级等措施提高竞争力；另一方面，国外优秀的半导体分立器件企业进入国内抢占市场份额。在日趋激烈的市场环境环境下，如果公司不能持续进行技术升级、提高产品性能、降低低成本产品以及优化营销网络，则很可能在未来的市场竞争中丧失优势，从而对公司持续盈利造成不利影响。

3、产品替代风险

半导体分立器件行业属于技术密集型行业，具有技术和产品更新换代速度较快的特点。半导体分立器件下游应用领域日新月异，产品的形态、功能以及差异化需求在短时间都可能发生很大变化，这都导致半导体分立器件产品生命周期越来越短，替代现象日趋显现。未来，随着新材料的应用和新技术的不断突破，在满足经济性能条件下，新一代的半导体分立器件产品将可能出现，并对现有的产品形成一定冲击。如果公司不能持续紧跟行业发展前沿并进行技术升级换代、研发适定行业和市场的产品，则公司存在产品被替代的风险，从而失去持续经营能力。

4、采购价格波动风险

芯片代工和封装服务为公司主要的采购内容，占产品成本的比重较大。

芯片代工和封装服务价格的波动将对公司的经营业绩产生一定影响。芯片代工价格一方面受到晶圆材料价格和制造成本、人工成本影响，另一方面则受到芯片代工企业投资规模和产能影响；封装服务价格受到原材料价格和人工成本等影响。报告期内，公司与国内主要的芯片代工企业和封装测试企业建立了较为紧密的合作关系，对其采购价格在一定区间内合理波动，且公司亦能够通过适度调整产品结构 and 价格、产品技术升级等方式进行应对，但是，如果芯片代工和封装服务的市场价格持续大幅上涨、而公司无法采取有力措施进行应对，则将对公司盈利能力造成不利影响。

（二）运营风险

1、供应商依赖的风险

公司是半导体专业化垂直分工企业，芯片代工及封装测试环节主要通过向供应商采购。公司拥有涵盖了华虹宏力、华润上华、中芯集成等国内少数几家具备 MOSFET、IGBT 等 8 英寸半导体芯片代工能力的本土芯片代工供应商，并不断拓展韩国等地区芯片代工供应渠道。而在封装测试环节，公司主要与长电科技（600584）、安靠集团（Amkor）、通富微电（002156）等全球领先的封装测试企业合作，一定程度上也保证了公司产品的前瞻性。由于半导体行业垂直分工的特殊性，专注于芯片设计环节的企业在更换供应商后一般不会轻易更改；同样，芯片代工及封装测试企业如若选择客户则需重新调整产线、设备技术参数、产能排期等，这将形成较大的更换成本。因此，双方在一定程度上相互依赖。如果公司主要供应商产能严重紧张或者双方关系恶化，则可能导致公司产品无法及时、足量供应，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

2、供应链管理不善风险

半导体分立器件行业高度分工协作，产业链包括芯片设计、芯片制造、封装测试、对外销售等环节，各个环节相互依存、高度相关。行业内企业根据分工不同采用垂直一体化或垂直分工模式，其中部分垂直分工模式的企业主要负责芯片设计研发和销售环节，而将芯片制造、封装测试环节主要委托给专业代工厂商完成，因此，其产品质量、交货时间、生产能力等都与产业链其他环节紧密相关。公司为专业化垂直分工企业，与行业内优秀的芯片制造和封装测试厂商建立了长期、稳定的合作关系。公司建成封装测试产线，实现少部分功率器件的自主生产，公司不断加强生产环节的质量、成本管控，保障产品的品质。但是，如果公司对供应链及生产环节管理不善，导致产品质量、交付及时性等出现问题，则会影响公司产品销售和品牌声誉，对公司的经营造成不利影响。

3、新产品开发风险

公司销售的产品按照是否封装可以分为芯片和功率器件，按照功能分类已形成沟槽型功率 MOSFET、超结功率 MOSFET、屏蔽栅功率 MOSFET、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）以及功率模块等多品类产品系列，且 MOSFET 等产品系列较为全面。公司在现有产品的基础上，仍紧跟半导体分立器件行业发展前沿，以国际一流企业的最新技术和产品为标杆，以下游市场需求为导向，不断进行新产品的开发。但是，半导体功率器件新产品的研发往往需要一定的时间周期，需要投入较多的人力成本和资金成本，且面临较大的失败风险，或者开发的新产品尚不具备商业价值，可能导致前期的各项成本投入无法收回，从而影响公司经营业绩。

4、产品质量控制风险

半导体分立器件属于基础性电子元器件，为下游产品的核心部件之一。半导体分立器件的产品生产对性能要求严格，电子元器件质量出现问题将对下游客户的产品销售和品牌产生不利影响。因此，半导体分立器件下游行业对器件的质量非常重视，往往在采购前和合作过程中均需反复验证和测试。公司始终将产品质量控制作为持续发展的关键要素之一，建立了较为健全的质量控制体系，并在各个环节严格把控，产品质量整体保持稳定。但是，半导体分立器件技术和工艺复杂，在不同环节很可能由于多种因素导致产品质量不佳或性能下降，从而导致质量纠纷，影响公司的市场地位和品牌影响力。

5、经营模式风险

公司主要采用 Fabless 经营模式，专注于 MOSFET、IGBT 等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售环节，芯片主要由公司设计方案后交由芯片代工企业进行生产，功率器件主要由公司委托外部封装测试企业对芯片进行封测代工而成，尽管公司已初步完成先进封装测试生产线的建设，将少部分芯片自主封装后对外销售。由于公司本身不具备芯片制造能力以及封装测试生产线规模相对较小，芯片制造、封装测试环节仍需依托芯片代工企业和外部封装测试企业。为保证公司产品供应环节的稳定，公司已与多家具有雄厚实力的芯片代工企业和封装测试企业建立了长期稳定的合作关系。但在半导体分立器件行业生产旺季，可能会存在芯片代工企业和封装测试企业产能不足，不能完全保证公司产品及时供应的风险。

（三）技术风险

1、技术升级的风险

半导体分立器件行业为技术密集型行业，行业竞争的关键在于新技术、新产品的竞争。新技术、新产品的研发及产业化应用周期长、投入大，且新产品量产后，还面临着产品更新换代速度快、产品不能满足市场需求变化的风险。公司拥有高素质的技术研发团队，并与科研院所从事功率功率器件设计领域开展长期合作。公司还成立了技术研发小组专门从事新技术和新产品的研发，并依据行业技术发展趋势、市场动态及客户需求确定公司的产品研发规划和具体措施。但是，如果公司的新技术、新工艺的研发未能持续升级换代，新产品的产业化未能保持市场领先地位，将会对公司的市场竞争和经营产生不利的影响。

2、技术人才流失风险

研发设计能力是半导体分立器件企业竞争力的核心之一，其主要来源于企业的研发技术人员，因此半导体分立器件产业的快速发展对专业技术人才产生了巨大的需求。公司在产品技术升级、新产品推出、产品的售后服务等方面高度依赖于公司的研发团队。自成立以来，公司已培养和引进了一批高素质研发人才，并通过实施股权激励、签订保密协议等多项激励和约束机制，以维系研发团队稳定。但是，如果公司核心研发人员大量流失，公司的研发能力、新产品开发及持续盈利能力将受到一定的影响，并可能给公司带来新的竞争对手。

（四）财务风险